

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 25 年 9 月 12 日 (2013.9.12)

【公開番号】特開 2011-91376 (P2011-91376A)

【公開日】平成 23 年 5 月 6 日 (2011.5.6)

【年通号数】公開・登録公報 2011-018

【出願番号】特願 2010-207551 (P2010-207551)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/8234 (2006.01)

H 0 1 L 27/088 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 27/08 (2006.01)

G 0 2 F 1/1368 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/14 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/08 1 0 2 B

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 1 9 A

H 0 1 L 27/08 3 3 1 E

H 0 1 L 27/08 1 0 2 C

G 0 2 F 1/1368

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/14 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 8 月 7 日 (2013.8.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

駆動回路と、画素と、第 1 のトランジスタと、第 1 の配線と、第 2 の配線と、第 3 の配線と、を有する表示装置であって、

前記駆動回路は、前記第 1 の配線を介して前記画素に画像データを供給することができる機能を有し、

前記第 2 の配線は、第 1 の電位を供給することができる機能を有し、

前記第 1 のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のトランジスタのゲートは、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記前記第 3 の配線は、前記第 1 のトランジスタのオンまたはオフを制御する信号を供給することができる機能を有し、

前記第 1 のトランジスタは、チャネル形成領域を含む酸化物半導体層を有し、

前記第 1 のトランジスタは、デプレッション型であることを特徴とする表示装置。

【請求項 2】

駆動回路と、画素と、第 1 のトランジスタと、第 1 の配線と、第 2 の配線と、第 3 の配線と、を有する表示装置であって、

前記駆動回路は、第 2 のトランジスタを有し、

前記駆動回路は、前記第 1 の配線を介して前記画素に画像データを供給することができる機能を有し、

前記第 2 の配線は、第 1 の電位を供給することができる機能を有し、

前記第 1 のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第 1 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第 2 の配線と電氣的に接続され、

前記第 1 のトランジスタのゲートは、前記第 3 の配線と電氣的に接続され、

前記前記第 3 の配線は、前記第 1 のトランジスタのオンまたはオフを制御する信号を供給することができる機能を有し、

前記第 1 のトランジスタは、チャネル形成領域を含む第 1 の酸化物半導体層を有し、

前記第 2 のトランジスタは、チャネル形成領域を含む第 2 の酸化物半導体層を有し、

前記第 1 のトランジスタは、デプレッション型であることを特徴とする表示装置。

【請求項 3】

請求項 2 において、

前記第 1 の酸化物半導体層の膜厚は、前記第 2 の酸化物半導体層の膜厚よりも大きいことを特徴とする表示装置。

【請求項 4】

請求項 2 または請求項 3 において、

前記第 1 のトランジスタのチャネル幅は、前記第 2 のトランジスタのチャネル幅よりも大きいことを特徴とする表示装置。